



Международные конференции “Микро- и нанoeлектроника -2005” (МНЭ-2005) и “Квантовая информатика - 2005” (КИ-2005) состоятся в подмосковном пансионате “Липки”, г. Звенигород, с **3 по 7 октября 2005 г.** Эти конференции продолжат ряд регулярных конференций по микро- и нанoeлектронике, проводившихся в “Липках”: Всероссийские “МНЭ-1999”, “МНЭ-2001”, “КИ-2002”, и Международные (конференции SPIE) “ICMNE-2003” и “QI-2004”.

Последний срок подачи завлений и прием тезисов – **15 июня 2005**

Общая информация

С 3 по 7 октября 2005 года состоится **Международная конференция «Микро- и нанoeлектроника – 2005» (ICMNE-2005)** в подмосковном пансионате «Липки», г. Звенигород. Эта конференция продолжает ряд конференций проводившихся ранее: “МНЭ-1999”, “МНЭ-2001”, “КИ-2002”, “ICMNE-2003” и “QI-2004”. Российская конференция, в последние два года ставшая Международной конференцией SPIE, включает в себя все сферы микро- и нанoeлектронных технологий, физики и приборов. Главной целью ICMNE является представление современных достижений в этой области на обсуждение научной общественности. Конференция будет включать в себя выставку микро- и нанoeлектронного оборудования и приборов при участии московского представительства фирмы SEMI®.

Организаторы и спонсоры конференции:

Министерство промышленности, науки и технологий РФ. Управление информационных технологий. Российская академия наук (РАН). Отделение информационных технологий и вычислительных систем. Научный совет «Развитие микро- и нанoeлектронных технологий и приборов, твердотельные кубиты». Тихоокеанская академия материалов. Физико-технологический институт РАН (ФТИАН), Москва, Россия. Российское отделение SPIE Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), Россия. Образовательно-научный центр “МГУ-ФТИАН”. Фраунгоферовский институт интегральных систем и развития технологии, Эрланген, ФРГ. Институт физики полупроводников РАН, Сибирское отделение, Новосибирск, Россия. Московский институт электронных технологий (ТУ МИЭТ), Зеленоград, Россия. Zeiss & Leo NT-MDT, Co FEI Company SEMI (Москва) Компания [НИКС](#)

Язык:

Официальный язык – Английский

Представление материалов для публикации:

Вы можете скачать шаблон тезисов доклада (1 стр.) и требования к манускрипту полного текста доклада для публикации в Proceedings of SPIE в разделе [“Файлы”](#). Как тезисы, так и полные тексты публикуются на английском языке.

Файлы тезисов докладов направлять по адресу icmne2005@ftian.oivta.ru.

Порядок публикации:

Представленные на конференцию «ICMNE – 2005» одностраничные тезисы доклада будут опубликованы в виде брошюры до начала конференции. Полный текст доклада представляется автором по прибытии на конференцию в электронном виде и в твердой копии (1 экз).

SPIE (<http://www.spie.org/>) публикует полные тексты докладов в виде трудов конференции после проведения ICMNE-2005. Публикуются только те доклады, которые были представлены и обсуждены на конференции.

Предпочтительная тематика докладов:

- Материалы для микро- и нанoeлектроники. Кремний на изоляторе.
- Микро- и нанoeлектронные технологии и оборудование.
- Суб-100нм литография: ГУФ, ЭУФ, электронная и ионная литография, импринт.

Квантовая литография.

- Плазменные процессы.
- Имплантация.
- Эпитаксиальный рост. МВЕ. Планаризация.
- Мониторинг технологических процессов и детектирование момента их окончания в микро- и нанотехнологиях.
- Метрология и характеристика микро- и наноструктур.
- Моделирование технологических процессов и микро- и нанoeлектронных приборов.
- Развитие микро и нанoeлектронных приборов. Нанотранзисторы: МДП, одноэлектронные. Память и логические схемы на квантовых точках.
- Магнитные микро- и наноструктуры. Наномагнетики.
- Молекулярная нанoeлектроника. Микро- и наномеханика.

Представление на конференцию статей приветствуются как из академического мира, так и из промышленности. Около 80 докладов будут выбраны в виде устных. Все остальные будут представлены в виде постеров. Программа конференции будет включать в себя и приглашенные научные доклады. Программный комитет определит, в каком виде будет представлен научный доклад (устный или постер), однако пожелания авторов конечно будут учтены. Одностраничные тезисы докладов должны содержать оригинальные научные результаты (не обзоры уже выполненных работ).

Комитеты:**Международный комитет**

Председатель: Е.Велихов, Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва

Зам. председателя: К.Валиев, Физико-технологический институт РАН, Москва

Члены комитета:

Д. Аверин, Stony Brook University, NY, U.S.A.

А. Асеев, Институт физики полупроводников РАН, Новосибирск

V. Benine, ASML, Netherlands

F. Briones, Instituto de Microelectro'nica de Madrid, Centro Nacional de Microelectro'nica-CSIC, Spain

R. Chabicovsky, Technical University, Vienna, Austria

Р. Чиковани, Технический Университет, Тбилиси, Грузия.

M.C. Chon, Chon Int.Co, South Korea

C. Claeys, IMEC (Belgium)

Ю. Гуляев, Институт Радиоэлектроники РАН, Москва
J. Gyulai, Technical University, Budapest, Hungary
D. Esteve, Quantronics group SPEC-CEA Saclay, FRANCE
H.L. Hwang, Taiwan
Г. Кароян, Ереванский институт, Армения
R. Kulkaski, M.E.C. tech, Inc., U.S.A.
Ф. Кузнецов, Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск
В. Лабунюк, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Минск, Белоруссия
В. Литовченко, Институт физики полупроводников Национальной Украинской академии
наук, Киев, Украина
O. Manck, Technical University, Berlin, Germany
J.I. Nishizawa, Semiconductor Research Institute, Japan
Ю. Пожела, Институт физики полупроводников, Вильнюс, Литва
C.N.R. Rao, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, India
H. Ryssel, Fraunhofer Institute of Integrated Systems and Devices Technology, Erlangen, Germany
A. Schlachetzki, Technical University, Braunschweig, Germany
Р. Сурис, Институт им. Иоффе, С.-Петербург
В. Фареник, Научный физико-технологический центр Минобразования и науки и НАН
Украины, Харьков

Программный комитет

Председатель: К. Валиев, Физико-технологический институт, Российская академия наук,
Москва.

Зам.председателя: А. Орликовский, ФТИАН, Москва

Зам.председателя: И. Неизвестный, Институт физики полупроводников РАН,
Новосибирск

Члены комитета:

А. Афанасьев, ФТИАН, Москва
А. Александров, МГУ им. М.В. Ломоносова
В. Аристов, ИПТМ РАН, Черноголовка
В. Бетелин, НИИСИ РАН, Москва
Ю. Чаплыгин, Московский институт электронной техники (ТУ), Зеленоград
В. Джуньян, АО «АНГСТРЕМ», Зеленоград
Б. Грибов, Государственный научный институт сверхчистых материалов, Зеленоград
L. Frey, Fraunhofer Institute of Integrated Systems and Devices Technology, Erlangen, Germany
Ф. Комаров, Белорусский Государственный Университет, Минск
П. Копьев, ФТИ им. Иоффе, С.-Петербург
Ю. Копаев, ФИ им. Лебедева РАН, Москва
В. Курчидис, Институт микроэлектроники и информатики РАН, Ярославль
В. Мокеров, Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН, Москва
Г. Красников, Концерн «Научный центр», Зеленоград
В. Панченко, Институт лазерных и информационных технологий РАН, Шатура
К. Салихов, КФТИ КНЦ РАН, Казань
А. Сигов, Московский институт радиотехники, электроники и автоматизации (ТУ)
Н. Салашенко, Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
И. Хайбуллин, Физико-технический институт Казанского научного центра РАН, Казань

Организационный комитет

Председатель: А. Орликовский, ФТИАН, Москва.

Зам.председателя: Ю. Чаплыгин, МИЭТ (ТУ), Зеленоград

Зам.председателя: Е. Горнев, АООТ МИКРОН, Зеленоград

И. Абрамов, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Белоруссия

Е. Акопов, SPIE, Москва

В. Борисенко, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Белоруссия

А. Бухараев, КФТИ КНЦ РАН, Казань

А. Васильев, Connecticut University, U.S.A.

А. Васильев, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматизации (ТУ)

В. Вербицкий, НИИ «Микроприбор», Киев, Украина

В. Вьюрков, ФТИАН, Москва – член Ученого секретариата ICMNE-2005

А. Горбачевич, Московский институт электронной техники (ТУ), Зеленоград

В. Гранько, «Интеграл», Минск, Белоруссия

В. Гурович, Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва

А. Калинин, АООТ «Ангстрем», Зеленоград

М. Королев, Московский институт электронной техники (ТУ), Зеленоград

А. Ларионов, ФТИАН, Москва - член Ученого секретариата ICMNE-2005

С. Никитов, ИРЭ РАН, Москва

Ю. Ожигов, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

О. Пчеляков, ИФП СО РАН, Новосибирск

В. Рубаев, директор фирмы НИКС

К. Руденко, ФТИАН, Москва – Ученый секретарь ICMNE-2005

Я. Суханов, ФТИАН, Москва – член Ученого секретариата ICMNE-2005

А. Фамицкая, SEMI, Москва

Л. Федичкин, Clarkson University, U.S.A.

С. Шевчук, ФТИАН, Москва - член Ученого секретариата ICMNE-2005

М. Чуев, ФТИАН, Москва

Ученый секретариат

Руденко Константин Васильевич – Ученый секретарь ICMNE-2005

Вьюрков Владимир Владимирович

Суханов Яков Николаевич

Шевчук Сергей Леонидович

Лукьянова Ирина Юрьевна



Физико-технологический институт (ФТИАН) Российская Академия наук

117218 Москва, Россия, Нахимовский просп., 34

Тел.: +7 095 332 4918

Факс: +7 095 125 3826